コヒーレント単色X線の医療応用

日本大学大学院総合科学研究科 佐藤 勇

1. はじめに

日本大学では、1956年に古田会頭原子力研究を 推進するために、湯川秀樹博士らの協力を得て、195 7年に原子力センターを創立し、1963年に核融合を 目的とする原子力研究所を設立した。湯川博士がが んに罹病すると、1975年に、理工、医、歯学部の合同 でπ中間子の短寿命と特異な電離損失を活用したが ん治療計画(π計画)が企画され、熊谷寛夫博士を招 請し、原子力研究所にπグループが結成された。当 初、治療用加速器は電子リニアックを基盤に進められ たが、グループリーダーの熊谷博士は不幸にも途中で 逝去された。1978年原研から物理部長の塚田博士が グループリーダーに就任され、1982年には治療用加 速器はCWマイクロトロンに変更され、科学技術庁より 科学技術振興調整費の助成を受け、35MeVマイクロ トロンがモデル加速器として建設されました。1984年、が電子ビーム照射による放射線損傷を受け、使用不 高崎市に中間子ガン治療施設の誘致を申し入れたが、能になった。急遽、アンジュレーターの周期長と周期 1985年には塚田博士が逝去されて、1988年に後任 に東北大から鳥塚賀治博士が就任し、π計画を推進 されましたが、しかし、治療用マイクロトロンには莫大建 設費を必要と、且つ治療経費が高額なることから、建 設資金調達の目途が立たず、π計画は断念せざるを 得なかった。35MeVモデルマイクロトロンは長波長自 由電子レーザーの電子ビーム源に転用することになっ た。しかしながら、マイクロトロンの電子ビーム強度は 微弱で、増強の見込みが立たないため、高エネルギ ー物理学研究所(KEK)の協力を得て、マイクロトロン の電源を電子リニアック用に改造し、125MeV電子リ ニアックを機軸とする短波長自由電子レーザー(FEL)長発振に成功したが、発振は非常に不安定で共同利 に移行した。1996年に高エネルギー加速器研究機 構(KEK)と共同研究を提携し、KEKがBファクトリーは、FEL共振器ミラーの多層膜にあり、FELが発振し 計画を進めるために入射器のエネルギーを2.5GeV レーザー強度が上昇すると多層膜の耐性限界を超え

から8.6GeVに増強するに伴って、不用となった電子 リニアック本体の一部を、旧日本大学原子力研究所 (現日本大学量子科学研究所電子線利用研究施設) に移設して、FEL発生装置の建設を開始した。このF EL計画は、電子銃、プレバンチャー、バンチャー、レ ギュラー加速管で構成される極普通の電子リニアック の構成で、且つ、短パルス用クライストロン(パルス幅: 2.5 μ S)をパルス幅25 μ Sで動作させ、短波長自由 電子レーザー(発振波長:0.3~6 µ m)を発振させる 常識から外れた無謀とも思える試みであった。

当然、不測事態が予想され電子線利用研究施設(L EBRA)では、そのために、KEKと共同研究を提携し、 クライストロンの高周波窓の故障やパルス電源などの 不安定性などに対峙し、電子リニアックの高度化研究 を進め、1999年には電子リニアックの長パルス運転に 成功した。一方、学内研究者から高性能なX線源が欲 しいとの要請があり、FELと同様に可変波長で高輝度 単色X線発生が可能であるパラメトリックX線放射(PX R)の開発研究に着手した。この間、FEL発振を試み たが、加速器を運転中にアンジュレーターの永久磁石 数を変更し、永久磁石を交換するとともに、同時に、ビ ームプロファイルモニターやービーム位置モニターも 直接可視方式から間接計測方式に切り替えた。

2000年4月に、LEBRAは私立大学学術高度化の 研究拠点に選定され、また「可変波長高輝度単色光 源の高度利用の研究」が私立大学学術研究高度化推 進事業(学術フロンティア)に採択され、FELやPXR の特色を最大限に活用する共同利用実験を推進する ことになった。(光源の配置は図1を参照)

2001年3月にはFEL実験棟も完成し、4月にFEL 発振実験を再開し、2001年5月、FEL1.5µmの波 用実験に提供できる状態ではなかった。その主な要因

瞬時に多層膜が破損し、レーザー発振が停止した。共 振器のミラーを多層膜ミラーから金属ミラーに交換し、 且つ、クライストロンパルサーの直流高圧電源を再調 整など、自由電子レーザー発生システムと電子リニア ックの高周波源の抜本的な改良と性能向上を重ねた 結果、FEL発振は安定し、可変波長FELとしては世 界最短波長発振領域(800~6000nm)を担う、世界 最大のFEL実験施設(ビームライン9本)が完成し、20 03年10月、共同利用実験を開始した。更に、この高 性能の電子ビームを使って、可変波長の単色X線源 の開発を進め、2004年4月、共同利用実験が可能な PXRの実用化に成功した。また、PXRの基本特性を 計測する課程に於いて、PXRはブラック条件を満たす 方位に対してX線エネルギーが一次関数的に僅かに 変化する準単色X線源^[1]であることを示し、更に、動植 物のイメージング映像^[2、3]からブラック条件を満たす方 向に放射されるX線波束は空間コヒーレンスに富むX 線(位相の揃ったX線)、即ち、PXRが空間干渉X線 源であることを明らかにした。一方、イメージング撮像 に要するX線照射の実時間が非常に短いことから、P XRは高輝度X線源であることを示めした。

現在、100MeVの電子ビームでSi単結晶(111)並 びに(220)を照射すると、4~34keVのエネルギー可 変範囲の空間干渉単色X線が得られている。また、こ れらのX線は共同利用実験に供与している。

Reference

[1] Y. Hayakawa, et al., Phys. Soc. Jpn. 67 (1998) 1044.
[2] Y. Hayakawa, et al., Nucl. Instr. and Meth. B227 (2005) 32

[3] T. Kuwada, et al., "Phase Contrast Imaging of Biological Materials Using LEBRA-PXR", SRI2006 The Ninth Inter. Conf. on Synchrotron Radiation, May 28-June, 2006 Daegu, Korea.

2. パラメトリックX線放射(PXR)の沿革

1957年に、ソ連のFainbergとKhizhnyakは、誘電率 が周期的に変化する媒体を荷電粒子が通過すると特 異なX線が発生することを示唆¹⁾した。この種の放射は、



1970~1980年代に、濃縮された媒質中の高エネル ギー電磁プロセス²⁾、高エネルギー粒子の結晶中の チャネリング、放射と反応³⁾、X線のトランジション放射 現象^{4,5,6)}として、加速器ある世界中の至るところで研 究された。又、ソ連では、1980年代の後半から、ブラ ック角近傍の実験として、Tomskの900MeV電子シン クロトロンによるパラメトリックX線放出(PXE)⁷⁾、或い は、Kharkovの25MeV電子リニアックによるパラメトリ ックX線放射(PXR)の大まかな特性^{8,9,10)}が測定さ れた。一方、A.V.Shchaginらは、Kharkovの電子リニア ックと分解能の良いX線検出器を使って、PXR特性を 測定し、その詳細構造¹¹⁾を明らかにした。

PXE、或いは、PXRは高エネルギーの電子ビーム で単結晶を照射すると、電子ビームが制動されて輻 射するγ線以外に、単結晶中を荷電粒子が通過する ときに発生する光子の振る舞いが、チェレンコフ光に よく似た性質の X 線を発生するので、 quasi-Cherenkov と称している。しかし、PXRの存在 は、シンクロトロン放射の陰に隠れて話題に上らなか ったが、ソ連で1980年代に、この X 線が単色に近い 特性をもつことが実験的に確かめられると、次第に注 目されるようになった。

日本では、学芸大の新田¹²⁾が結晶内の Maxwell 方程式の摂動解を基本に結晶内で相対論的電子か らのコヒーレント放射(PXR)を解析的に表示すること 試み、広島大の遠藤¹³⁾、京都大の早川¹⁴⁾のグループ は、核研の電子シンクロトロンや京大の電子リニアック 使ってPXR計測実験を行った。しかしながら、これら のPXRは、発生源でγ線や中性子などの2次放射線 も同時に発生するために、PXRを放射線シールドで 囲い、これらの放射線と分離していたので、機動性と 多様性を欠き、共同利用実験などの X 線源としては 活用されていなかった。

Reference

 Ya. B. Fainberg and .A. Khzhyak, Zh.Eksp.Fiz.32 (1957) 883 M. L. Ter-Mikaelian, "High-energy electromagnetic processes in condenced media", Inter science tracts on physics and astronomy "(Wiley-Inter science, New York, 1972)

3) V. G. Baryshevsky, Channeling, radiation and in crystals at high energies (BGU, Minsk, 1982)

4) G. M. Garibyan and C.Yang, "X-ray transitions radiation" (Arm. SSR. Erevan, 1983)

5) D. Dialetis, Phys. Rev. A 17 (1978) 1113.

6) I. D. Feranchuc and A. V. Ivashin, J. Phys. 46 (1985) 1981.

7) A. N. Didenko et al., Phys. Lett. A 100 (1985) 177.

8) Yu. N. Adishchev, et al., Nucl. Instr. Meth. B 21 (1987)49.

9) R. O. Avakyan, et al., Pis'ma Eksp. Teor. Fiz. 45 (1987) 313.

10) D. I. Adejshvili, et. al., Dokl. Akad. Nauk SSSR 298 (1988) 844.

11) A.V. Shchagin, V.I. Pristupa and N.A. Khizhnyak, Phys. Lett. 148 (1990) 485.

12) H. Nitta, Phys. Lett., A 158 (1991) 270-274.

13) I. Endo, et al., Phys.Rev., E 51 (1995) 6305.

14) Y. Hayakawa, et al., Phys. Soc. Jpn. 67 (1998) 1044.

15) I. Sato et al., The 13th Sym. on Accel. Sci. and Tech.,Osaka, Japan, (2001) 117

16) Y. Hayakawa et al., Nucl. Instr. Meth. B 227 (2005) 32-40.

BXRの発生メカニズム

2000年4月、電子線利用研究施設では、図1に示 すように、FEL発生装置とPXR発生装置を並立させ、 また、図2の如く、高エネルギー電子ビームで第1単 結晶を照射しパラメトリックX線放射(PXR)を発生さ せ、そのPXRを第2単結晶で捕獲し電子ビームと同 一方向にブラック反射させて、常にPXRを定方位に 取り出すシステムを構築し、2004年4月、その実用化 実験に成功した。

単結晶に高エネルギー電子を入射すると、単結晶 を周期構造に形成する原子の電子群は、図3に示す ように、入射電子の近接電場で強く摂動され分極振 動する。



図2 パラメトリックX線放射実用化の基本構成



図3 飛行電子による単結晶原子の分極励起

その振動波は、図4に示すように、電磁波として 同心円状に拡散する。特に、入射電子が単結晶中を AからBまで飛行する間に、単結晶中の原子の多 数が電子の近接電場で摂動され分極振動するが、 その振動波(電磁波)の位相速度は、電子速度よ り速いので、電磁波はドップラー効果により、入 射電子の進行方向に対する方位角度で、その波長 が異なり、電子の進行方向(前方)に近い方位角 ほど、振動間隔が狭く短波長となる。

一方、図5に示すように、格子面間隔dの単結 晶の周期構造に配列された原子間を、結晶格子面 に対する入射角 θ で高エネルギー電子が通り抜け、 原子の摂動振動波が互いに干渉し、その干渉波成 分が入射電子と同方向に進行し、干渉波の波長を λ とすると、この干渉波は、下記のブラッグ条件 $2dsin\theta = n\lambda$ (1)

を満たすことになる。即ち、この干渉波は格子面 に対して角度 θ (電子の進行方向に対して2 θ の 角度)に反射される。

単結晶中を伝搬する振動波は、単結晶格子面で、 ブラッグ条件を満たすように、透過と反射を繰り 返して、単結晶の周期構造場で選別濾波されなが ら、最終的には結晶面から単色近い位相の揃った X線として放射されるとも言える。即ち、単結晶 の原子は、入射電子で摂動され、電磁波を放射し 色々な波長の電磁波が合成されるが、それらの電 磁波は単結晶の周期構造場(バンドパスフィルタ 一)で濾波され、特定の方位角には、特定の電磁 波が放出される。

従って、振動波は、常に格子面で単結晶中を反 射波と透過波に別れて拡散するが、図5に示すよ うに、反射波と透過波の何れの振動波の位相面も 幾何学的に揃い、可干渉性の特性を有することに なる。単結晶に入射した電子の電荷が単結晶原子 の殻内電子群を分極摂動(電子群と相互作用)さ せることは、電子の運動エネルギーが単結晶原子 の電子群の分極振動エネルギーとして原子に推移 したことを意味する。





図5 ブラッグ条件を満たす分極振動波の位相面

図6には、可干渉X線(空間干渉単色X線)発生の 概念図を示す。定性的には、単結晶の格子面のA点 からC点に向けて角度 θ で斜入射した電子によって、 電子軌道に隣接する単結晶の原子が摂動され分極 振動するが、電子の進行方向と同方向の分極振動波 成分は、恰も入射電子の搬送波の如くに振る舞う。搬 送波が結晶格子面で反射するとき、(1)式のブラッグ 条件を満足しなければならない。この場合、格子面で 反射された搬送振動波の位相が、B₁とB₄を結ぶ線上 で同相になることを、幾何学的に証明することは、容 易である。



図6 空間干渉X線の概念図

定量的に説明するには、入射電子と単結晶周期 構造場の間に、エネルギーと運動量の二つの保存 則が成立しなければならないので、複雑な証明が必 要になる。

例えば、電子が結晶に入射する前後のエネルギーを*E、E*、分極振動波エネルギーを*ħωと*すると

 $E=E' + \hbar ω$ (2) で記述される。ここで、ωは摂動角振動数、 \hbar は プランク常数で $\hbar = h/2 \pi$ である。

一方、運動量**p**の電子が、単結晶の周期構造場 である格子面に垂直な逆格子ベクトル**g**との相 互作用して、波数ベクトル**k**の光子を放出しPX Rとなると仮定すると、電子の運動量が**p**から**p**、 に推移した場合、その関係式は

p+*ħg=p'*+ *ħk* (3)
と記述される。一方、相対論的な電子の運動エネ
ルギー*E、E'*と運動量*p,p'*の関係は不変質量
保存則から

$$E^{2} = (\mathbf{p}c)^{2} + (m_{0}c^{2})^{2}$$
(4)

$$E^{2} = (p^{2}c)^{2} + (m_{0}c^{2})^{2}$$
(5)

で与えられる。ここで、(4)と(5)の差をとると $E^{2}-E^{2}=(pc)^{2}-(p'c)^{2}$ (6)

(E-E')(E+E') = (pc-p'c)(pc+p'c) (7) となる。一方、エネルギーや運動量の推移量が小 さい場合には、 $E+E' \sim 2E$ 、p+p'=2pと近似できる。 ここで、(7)に(2)と(3)を代入すると

$$m_0 \gamma \,\mathrm{c}^2 \hbar \,\omega = m_0 \gamma \,\mathrm{c}^2 \boldsymbol{v} \cdot \hbar (\boldsymbol{k} - \boldsymbol{g}) \tag{8}$$

と記述される。但し、 m_o は電子の静止質量、 γ はロ ーレンツ因子 $\gamma = (1-(\mathbf{v}/c)^2)^{-1/2} = \mathbf{E} + m_0 c^2/m_0$ c^2 、 \mathbf{v} は電子速度である。

(8)からωは

 $\omega = (\mathbf{k} - \mathbf{g}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{k}_{g} \cdot \mathbf{v}$ (9) と記述できる。但し、ここで、 \mathbf{k}_{g} は電子が単結晶 原子を摂動する励起子(虚光子)の波数ベクトルとす る。

(9)の左辺項のωは電磁波(実光子)の角振動数

であるから結晶の誘電率を & oとすると、

 $\omega = |\mathbf{k}| (c \epsilon_o^{-1/2}) = |\mathbf{k}| c^*$ (10) と記述される。但し、c*は結晶中の振動波(光子)の伝 搬速度である。振動波のエネルギーは、最終的に

 $\hbar \omega = \hbar c^* | \mathbf{g} \cdot \mathbf{v} | / (c^* - \mathbf{v} \cdot \mathbf{Q})$ (11) で表される。ここで、**Q**は放射振動波の放出方向に於 ける単位ベクトルであり、**Q**=**k** / | **k** | で記述[4, 5] される。

入射電子と放射振動波の放出方向が正確にBragg 条件を満たすならば、(11)の放射振動波のエネルギ ーカωとBragg 回折によって散乱されたX線エネルギ ーが等しくなる。このことは、Bragg 角を制御すること によって、振動波エネルギーの選択が可能であること を意味する。

一方、運動エネルギーEの電荷e、質量mの粒子が n個、厚さLの単結晶を通り抜けるときに、単位立体角 d Ωに放射される量子数 dNは、摂動論の一次近似に よると

$$\begin{split} dN/d\Omega &= \{e^2 n \omega L|_{\chi_g}(\omega)|^2/(2\pi\hbar\epsilon_0^3 v(c^* - v \cdot Q))\} \\ &\times \{|(\omega/c^*) Q \times ((\omega/c^{*2})v + g)|^2\} \\ &\times \{|(\omega/c^*) Q \bot - g \bot|^2 + (\omega/v)^2[\gamma^{-2} + (v/c)^2(1 - \epsilon)]\}^{-1} \\ &(12) \end{split}$$

と複雑な式で記述される [1,2,3] 。 ここで、v=|v|で

あり、Q ⊥ とg ⊥ は vに垂直な Q とg の成分である。また、
 $\chi_g(\omega)$ は、電気感受率の可変部分のフーリエ成分であり、

 $\chi_{s}(\omega) = -(4\pi e^{2}/m\omega^{2})(F(\mathbf{g})/V)$ (13) で与えられる。ここで、F(g)は結晶の構造因子であり、Vは単位ベクトルの大きさである[3]。また、電気 感受率の一定部分は、 $\chi_{0} = 1 - \varepsilon_{0}$ で表される。

一方、速度 v の電子ビームが Bragg 角 θ で逆格 子ベクトル g を持つ単結晶に入射すると、PXRエネル ギー $\hbar\omega$ は、(11)を2次元表記に変換すると

ここで、(14)を角度 ϕ で微分すると $d(\hbar\omega)/d\phi = -\hbar c^* |g| \beta \sin \theta \sin \phi / (1 - \beta \cos \phi)^2$ 二一 $\hbar \omega \sin \phi / (1 - \cos \phi)$ (15)

となる。ここで、 $\phi = 2\theta$ の場合、放射振動波のエネ ルギーはブラッグ条件を満たすエネルギーに等しくなる。即ち、 $\hbar\omega_B$ は

 $\hbar \omega_B = \hbar c^* |g| / 2 \sin \theta$ (16) と記述できる。振動数を波長 λ で表示すると、(16) は (1) となる。

Reference

 M. L. Ter-Mikaelian: High-energy electromagnetic processes in condensed media (Wiley-Interscience, New York, 1972) 332.

[2] A. V. Shchagin, V. I. Pristupa and N. A. hizhnyak: Phys. Lett., A 148 (1990) 485.

[3] H. Nitta: Phys. Lett. ,A 158 (1991) 270.

4. PXRの基礎実験

図2に示すように、高エネルギー入射電子が発生 する2次放射線(γ線、中性子など)とPXRを分離す ることにより、PXRの詳細な基本特性の計測が容易に なり、図7に示すような簡単な実験システムでPXRの 基礎実験が行われた。



図7 PXRの基礎実験システムの配置図

図8は、PXRでポラロイドフィルム(Pola.)を照射し て得られたX線吸収画像である。左右の明暗を分ける 線はフィルムに含まれる臭素(Br)の共鳴吸収端を示 している。画像はPXRの2次元的なエネルギー分布 を表わしている。垂直方向のエネルギー分散は非常 に小さく、水平方向のエネルギー分散は一次関数的 に分布している。また、図8には、共鳴吸収端の左側 に拡張X線吸収詳細構造(EXAFS)が確認でき、XA FSをイメージングとして捉えられることを示唆している。 PXR強度の角度分布とエネルギー分布の計算結果 を示す図9と定性的に一致することを証明され、PXR が準単色X線源であることを実験的に実証^[9]した。



図8 ポラロイドフィルムで最初に撮像したPXR



図 9 ブラック角7.5度のPXRスペクトル

図10は、サクラの薄い葉をPXRで撮像した画像であ る。軽い元素で形成される薄い生体組織の詳細な構 造は低エネルギー単色X線で撮像するとコントラス良 い画像が得られることが分かる。図11は、同様な考え から、13.5keVのPXRでICカードとアルミ箔(24、48、 96、192μm)を照射し、イメージングプレート(IP)で 撮影した吸収画像である。指向性の強い準単色X線 を使うと、コントラストの良いICカード内部回路画像が 得られることを示している。この画像には、図8と同様 に、イメージングプレート(IP)に含まれるBr共鳴吸収 端が明暗を区分けするラインとして現れている。



図10 7keVPXRで撮像した桜の葉



図11 13.5keVPXRで撮像したICカード

次に、IPを移動させて撮像する伝搬法の例を示す と、図12のような実験配置になる。



図12 伝搬法の実験システムの配置図

図13(a)は図12のIP₂、図13(b)は図12のIP₁の 位置で、それぞれイメジングプレート(IP)を用いて撮 像した蜘蛛のX線画像であり、撮像場所がIP₁からIP₂ へ移動すると蜘蛛の軟組織構造のコントラスト像が明 確に写し出された。



図13(a) IP₂の画像

図13(b) IP₁の画像

図14(a)、(b)、(c)には、試料(トカゲ)から2cm、 40cm、220cm離れた距離にIPをそれぞれ、セットし て撮像した画像を示す。特に、この画像はトカゲの骨 と軟組織の屈折率の違いによるX線位相差が距離に よって異なることを示している。これらの特異な現象は、 蜘蛛の軟組織やトカゲの骨でX線が屈折されて出現 した現象と考えられる。即ち、蜘蛛の筋肉とトカゲの 骨の屈折率の差によって、X線が集束する距離が違う ことを示唆している。また、この現象は、X線源の波束 位相が揃っていることを示し、蜘蛛の軟組織によって X線が屈折されてフォーカスしコントラストが強調され たことを意味する歴史的な画像である。



5. X線の位相差強調計測法について

ブラック条件を満たす方向に放射されるX線波束は可 干渉性に富むX線(位相の揃ったX線)であることを想 定し、動植物のイメージング映像[1,2]から突き止めること ができた。更に、位相の揃ったX線の特性を活用すると、 可視光領域の位相差顕微鏡とは異なる撮像物内の断 層画像が得られる。図14に示す計測システムは、単結 晶にX線を照射すると、単結晶のブラック条件を満たす 方向にX線が反射され、単結晶の格子定数と反射角度 からX線の波長が測定できる。また、Si 単結晶を僅かに 回転すると検出器のX線強度が a、b、c、d、e の曲線の ように変化する。この強度分布(ロッキング曲線)から単 結晶のブラック方位角、或いは、単結晶の構造が明ら かな場合はX線エネルギーを測定できる。この計測シス テムを使って、PXRの位相に関する基礎的実験が継続 され、CCDカメラやイメージングプレート(IP)を使って、 色々な試料の位相コントラスト画像や屈折コントラスト画 像を撮像し、これらの画像を分析し、PXRが可干渉性X 線源であることを実証[3]した。



図14 DEI法によるX線撮像の配置図

X線の位相が揃っている場合は、計測システムのA 点に試料を置いて撮像すると試料の構造がより強調さ れた屈折コントラスト像として撮像できる。この測定法を 回折現象が強調されるイメージング撮像法(Diffraction Enhance Imagining, DEI)と称している。

図15a)~(e)には、DEI計測法を用いてCCDカメラ か否かによって、そのコントラスト像が大きく変わる。 で撮像したトカゲ頭部の屈折コントラス像を示す。また、 図15f)にはトカゲの全体像を示す。図23(a)に記述し た+20Pは、図14に示したDEI法でアナライザーとし て用いられるSi単結晶をゴニオメーター上で回転させ る方向とパルスモーターに送るパルス数を意味し、単結 晶の回転角は10パルス=1/1000度である。また、2分 ×20は、2分間照射の撮像を20回分重ねた画像を意 味する。

図15(a)はトカゲ頭部半面の表皮コントラスト像、図1 5(c)はトカゲの頭部中央断面までの硬組織と軟組織の 複合構造を透過コントラス像、図15(e)はトカゲ頭部の 反対面までの硬組織と軟組織の複合構造を透過コント ラス像、並びに反対面の表皮コントラス像を、それぞれ 示しているように見える。



⊠15(a)−10P (b) -5P2 分×20 1分×10



図15(d) +5P 1 分×10



(e) +10P

2分×20



(c) 0P

1分×20

(f) トカゲの写真

ロッキング曲線の点から離れた状態で撮像 した画像ほど位相によるコントラスト(位相差像) が顕著になる。即ち、単結晶の格子結晶面に 平行な軸を中心に回転させると、恰も被写体の 表面から深部までの各層の断面構造を映し出した映像 の如くに見える。

このように、X線撮像はX線源の位相が揃っている

図16には、プラスチックなどの軽元素から成る平板 材と凸凹した板材に非干渉X線と干渉X線を照射する と、吸収コントラスト画像と位相コントラスト画像が形成 される相違を示す。軽元素を被写体とするX線画像で は、X線の吸収率が低いために画像に吸収コントラス トが出ない。これが白色X線では筋肉組織などのコン



図16 吸収コントラストと位相コントラスの相違

トラスト画像が得られない理由である。

図17には、単色X線エネルギーと物質電荷(原子 番号)に対する位相シフトコントラストと吸収コントラスト



図17 X線と物質の相互作用に於けるX線エネルギ ーと物質による位相シフトと吸収の相関

Reference

[1] Y. Hayakawa, et al., Nucl. Instr. and Meth. B227

の相関を示す。

(2005) 32.

[2] T. Kuwada, et al., "Phase Contrast Imaging of Biological Materials Using LEBRA-PXR", SRI2006 The Ninth Inter. Conf. on Synchrotron Radiation, May 28-June, 2006 Daegu, Korea..

[3] Y. Takahashi, et al, "Phase-contrast imaging with a novel X-ray source", AIP Conference Proceedings, 1221, 119-123, (2010).

6. 可干渉性単色X線を活用した画像診断

通常X線源(白色X線)では、軽い元素で形成され る生体の軟組織はX線吸収係数が小さいために、生 体軟組織構造の吸収コントラスト像を得ることは困難 である。吸収コントラスト画像と位相コントラスト画像の 相違を比較するために、図18(a)には、ネズミの心臓 (カラー写真を、図18(b)、(c)には、歯科診断用X線 源(制動輻射X線:白色X線)と一般用X線源でネズミ の心臓をイメージングプレート(IP)で撮像した2枚の 画像(松戸歯学部の寒河江グループ提供)を、また、 同じネズミの心臓をDEI法でCCDカメラとIPを用いて 撮像した位相コントラスト画像を、それぞれ図19(a)、 (b)に示す。



図18(a) (b) 60kV. (c) 40kV. ネズミの心臓 6mA 125mA のカラー写真 50ms 10ms

図20には、17.5keVPXRによるネズミの腎臓側 面をIPで撮像した吸収像、DEI法を用いて撮像した 位相像、並に屈折像を示す。吸収像はネズミの腎臓 にIPを密着して撮像し、屈折像は、画像処理により 位相像から吸収像を差し引いた画像である。吸収像 は干渉性単色X線で撮像したものであり、普通の白 色X線で撮像した画像よりコントラストが強調されて いる。

図20、21の屈折画像には腎臓の空洞表面の凹 凸が描かれている。表面に異常があれば観測可能 であることを示唆している。撮像時間は、何れも30分 であるが、積算照射時間は18msであり、PXRが高輝 度であることを示唆している。

X線源が単色で波束位相が揃っているならば、図12 に示した伝搬法や図14に示したDEI法で撮像した内 蔵軟組織などの被写体を、一定の間隔で撮像し、そ





図19(a) CCDカメラ 17.5keV, 300s,

図19(b) IP 17.5keV,1800s, 積算照射時間= $60 \mu s$ 積算照射時間= $360 \mu s$



図20 17.4keVPXRで撮像したマウス腎臓側面



図21 マウスの正面写真と17.5keVPXRで撮像 した位相コントラスト画像と屈折コントラスト画像 2009/07

れらの屈折コントラスト画像をコンピューターで画像処 理を行い立体画像に合成すれば、被写体の内部構 造像の3次元的表示も可能であり、この方法が構築さ れれば、X線CTやMRIに匹敵する医療診断となる可 能性が高い。

また、これらの画像の比較から明らかなように、干渉 性単色X線による画像診断では、少ないX線量でコン トラストの良い画像が得られている。従って、干渉性単 色X線を用いた画像診断では、少ない被爆量で多く の情報が得られる利点がある。

研究施設では、PXRの第1単結晶をSi(111)から Si(220)に交換し、PXRの高エネルギー化を試みた。 その結果、PXRは、4keV~35keVの可変波長単色 X線の発生が可能になった。

図22には、単結晶のSi(111)をSi(220)に交換し、 高エネルギーPXRで撮像した蛍光電球の吸収像を 示す。このエネルギー領域では、造影剤であるヨウ素 の吸収端(33.2keV)を活用できる。



25.5 keV

33keV

図 22 Si(220)のPXRで撮像した蛍光電球 2009/3

PXRはイメージング画像を撮像するX線照射の実時 間から高輝度X線源であることを裏付けた。以上のP XRの基礎実験から、PXRが可干渉性準単色X線(コ ヒーレントX線)であることが明らかになり、周囲の青壮 年の方々が、不幸にもがんで死去されたことが動機に なり、コヒーレントの特長であるX線集束性と波 長可変な単色X線の特性を最大限に活用し、ガン などの腫瘍の放射線治療と診断が出来ないかの検 討を開始した。

7. PXR強度の評価

日大電子線利用研究施設に設置されている電子リ ニアックによるパラメトリックX線放射(PXR)は、表1に 示すような加速器パラメーターで運転されている。

一方、図13、図14、図19(a),図19(b)に示すよう な屈折コントラスト画像は15~30分の照射時間を要 するが、X線の実照射時間は60~360 µ sであり、非 常に短い。

これはパラメトリックX放射が非常に高い輝度を有していることを意味する。また、X線の立体角は、PXRの発生源である第1単結晶から約8m離れた地点で100

mm φ である。100mm φ の断面積に約2×10¹⁰個の X線束数が照射されると、イメジングプレートやX線CC Dカメラの感度に依存するが、現在は位相コントラスト 画像1枚が撮像できている。

これは、第1単結晶で10⁷個/秒の空間干渉X線が 発生すると、位相コントラスト画像1枚の撮像に30分を 必要とすることを意味する。

一方、電子ビームのマクロパルス幅が広いと、電子 ビームパルスの後方ではX線強度が低減する現象が 観測されている。最近は、電子ビームのマクロパルス 幅を1~5 µ Sに狭めてPXRの基礎実験を行ってい る。

これは、Si単結晶のデバイ温度(640K)が低いため、 電子ビームのマクロパルス幅が広くなると、電子ビーム がSi単結晶を通過中に発生する電離損失熱で、Si単 結晶の温度が上昇し、デバイ温度に近づき、結晶構造 が崩れてブラック条件がずれることが原因と考えてい る。

従って、単結晶の厚さの最適化によって、X線の発 生強度は大きく変わる可能性があり、これは今後の重 要な研究課題である。

最近の基礎実験では、0.2mm厚さの板状をカミソリ の刃のように削いだ形状のSi(111)単結晶に、5Hzの 繰り返し数、4µSのマクロパルス幅、135mAのビーム 電流の電子ビームを照射すると、実験室で17.5keV 単色X線の1×10⁸個/秒の線束強度が得られている。

これは、電子数が1.2×10¹⁴個で17.5keV単色X 線が1×10⁸個発生したことを意味する。即ち、10⁶個 の電子で約1個の17.5keV単色X線を発生させたこと になる。この場合、平均ビーム電流が10分の1に軽減 される可能性がある。

これらの情報やデーターを基礎に、X線影像が毎 秒1枚撮像できるX線源の概念設計を試み、更にコヒ ーレント単色X線によるガン治療と診断ができないか の検討をはじめた。

表1 PXR運転パラメーター

電子ビームエネルギー	100 MeV
マクロパルスビーム電流	100 mA
マクロビームパルス幅	$4 \sim 10 \mu s$
マクロパルス繰り返し数	$2\sim$ 5pps
平均ビーム電流	$0.8\sim 5\mu\mathrm{A}$
電子ビームミクロパルス幅	3.5ps
加速周波数	2856MHz
ミクロパルス間隔	350ps
X線エネルギー	$5\sim 35 \mathrm{keV}$
単色X線強度	10 ⁷ ~10 ⁸ 個/秒
屈折イメージング撮像時間	10~30分
積算電子ビーム照射時間	$60{\sim}360\mu{ m s}$

屈折コントラス像が毎秒1枚撮像するには、表1の 平均ビーム電流(2µA)の約2000倍、即ち、平均4 mAの電子リニアックが必要となる。この場合、電子リ ニアックの電子ビーム電力は400KW(100MeV×4 mA)となる。これはパルス運転している通常の常伝導 電子リニアックの性能仕様限界を遙かに超えている。 更に、このビーム電力エネルギーを高エネルギーの 状態でダンプ(鉛などの物質に吸収させる)とy線や 中性子などの2次放射線が大量に発生し、膨大な放 射線シールドが必要となる。また、収納建屋も大きくな る。

一方、PXR発生に用いられる単結晶の厚さは、0. 2mmであるが、7.5度の斜入射では、実効的な厚さは1.5mmとなる。この場合、単結晶で100MeV電子 ビームが失う制動放射エネルギーは、約1.5MeVとなる。

通常の電子リニアックでは、加速管の高周波損失が 大きいため電子ビームからエネルギー回収ができな い。従って、残りの約98.5%の電子ビームエネルギ ーをビームタンプに捨てられている。このような状況を 避けるために、高エネルギー電子ビームの電力を高 周波電力として回収し、加速に再利用するエネルギ ー回収型電子リニアックの開発を進めた。

8. 可干渉性単色X線によるがん治療の検討

レントゲンがX線を発見して以来、一世紀を経過し たが、可干渉性X線源の開発は、最近である。

PXRの干渉性の特性を活用して、フレネルレンズ などを使って図23に示すように、X線をピンポイントに 集束し、がん腫瘍を照射すると、どうなるかを検討し た。

これは放射線治療における理想的な定位照射に 相当する。即ち、単色X線を1個放射できるX線源を 無数に並べて4π方向から3次元的に照射する、γナ イフに相当する。一方、可干渉性単色X線を3次元的 に集束して、生体組織の深部にあるがん腫瘍を治療 するには、高エネルギーのX線が必要となる。治療の 対象を人間に限定すると、人体表面から10cmの深 部にあるがん腫瘍を目標すると、治療目的はほぼ達 成できる。

また、生体軟組織の比重が水の比重がとほぼ等価 であることを考慮すると、10cmの深部にあるがん組 織を照射して治療効果を上げられる適正なX線のエ ネルギーは、図24を参照すると、40keV程度のX線 エネルギーである。



図23 X線集束照射によるがん治療の概念図







図25 水漕中のX線束の集束

一方、可干渉性単色X線束を3次元的に集束する と、線束の線量分布が単位面積当たりのX線束数に 比例することから、集束X線の水中に於ける単位面積 当たりの線量を計算し、生体軟組織の線量分布を推 定した。

例えば、可干渉性単色X線の線束が円形に一様分

布すると仮定し、図24に示すように、X線束を3次元 的に1点に集束させた状態で、水槽照射に於ける水 中線量分布を計算する。ここで、X線エネルギーに対 する水の吸収係数を μ 、比重を ρ とすると、質量減衰 率 α は $\alpha = \mu / \rho$ で記述されるが、全X線束数N₀の 減衰は、水槽表面からの距離 d に依存し、d に於 けるX線束数N(d)は、

 $N(d) = N_0 e^{-\alpha d} \tag{17}$

で与えられる。また、d に於ける単位体積当たりのX 線の線量密度F(d)は、線束数N(d)を照射面積S(d) で割った商に比例し、

F(d) = N(d)/S(d) (18) と記述される。S(d)は、図25に示すように、X線集束 が双曲線を基軸とする d の自乗の関数で記述する と、d の増加と共に照射面積が減少し、集束点で最 小値になり、集束点を通過すると増大する。ここで、双 曲線の漸近線は、レンズの明るさF値に等価と仮定し、 水槽表面のX線束の半径をRo、水槽表面からの距離 d に於ける照射半径をR、焦点までの距離をdo、焦点 に於けるX線束の半径をRsとすると、双曲線の基本 式、R²/Rs²-(d-do)²/A²=1、並びに、d=0でR =Roの境界条件からAが求められ、最終的にS(d)は S(d) = π Rs²{1+(d-do)²(Ro²-Rs²)/Rs²do²}

(19)

となる。

また、F値 $(d_0/2R_0)$ をF5に相当するように、X線束の 集東パラメーターを、 d_0 =100mm、 R_0 =10mm、Rs =0.5mmに設定して、(17)~(19)を使って水漕を 通過する集束X線の単位体積当たりの線量損失を計 算した。20~100keVのエネルギー領域の集束X線 の規格化相対線量分布を図26に示す。同様に図27 にはF5相当に集束した20keVX線束を、 d_0 =25mm、 Rs=0.5、0.25、0.1,0.05mmのパラメーターに設 定し、規格化した相対線量分布を示す。ここで、規格 化相対線量とは、水槽表面の単位面積当たりの線量 を1と規格化した相対線量を意味する。また、図26か ら明らかなように、30keV以下の集束X線は生体表面 から100mmの深さにある腫瘍には、正常組織との相 対線量比が小さくなるので治療効果が期待できない が、しかし、25mm深さの腫瘍組織には、図27から明 らかなように、F5相当に集束した20keVのX線照射 でも、集束点の照射面積の直径が0.2mm φ 程度で あれば、腫瘍組織と正常組織の相対線量比が大きい ので、治療効果も期待できる。



図26 20~100keVX線の水中に於ける規格化 相対線量分布

20keV集束X線の水中線量分布(F5)



図27 20keVX線の焦点を水槽の深さ25mmに

設定した規格化相対線量分布

図28には、水槽に、中性子線、γ線、白色X線、4 OkeV単色X線を一次元的に照射した場合の規格化 相対線量と重粒子ビームと陽子ビームが深さ100mm にブラッグ曲線のピークを創生するように入射エネル ギーを調整した水中の規格化相対線量分布、並びに、 40keVX線束をF5相当に3次元的集束し深さ100m mの水中に2mmφの焦点を形成するように照射した 場合の規格化相対線量分布を示す。



図28 水中の各種放射線の規格化相対線量

陽子線や炭素線などの荷電粒子照射では、図28 に示すように、生体内のエネルギー損失が極大(ブラ ックピーク)になる特性がある。この特性を活用し、照 射エネルギーを調整すると、線エネルギー付与(LET) が正常細胞の領域で低く、がん腫瘍の領域で高くな るように分布させることができる。従って、白色X線や 中性子線より放射線治療効果が大きくなる。

この様に、がんに対する放射線治療の課題は、正 常細胞とがん細胞の被爆線量の比を如何に大きくす るかにあり、特に、がん化した幹細胞には、この比が 大きい程、効果的である。40keV集束X線は、図28 に示すように、単位体積当たり吸収線量はハドロン粒 子などの軌道電離損失であるブラックピーク特性と同 様な分布を持つことを示唆している。一方、ガンなど の腫瘍に集合するX線共鳴吸収特性を有する物質を 探索して単色X線による腫瘍などの軟組織のX線映 像を立体画像の構築の可能性を探っている。

例えば、前述の40keV単色X線の3次元照射では、 深さ100mmのX線強度は水槽表面強度の約30倍に なるが、厚さ100mmの水中を通過中にX線は散乱や 吸収されて、線束数は92%が消失し、到達線束数は 水槽表面の8%に低減する。40keVX線の3次元照 射によるがん治療でも、がん組織に到達するまでに散 乱吸収で消失する92%のX線が、正常細胞に悪さを するのではとの議論があり、途中の散乱吸収するX線 について線量分布を徹底調査した。そこで、40keV 単色X線の10⁵を1束に水槽に照射し、水槽中に於け るX線の散乱吸収分布を、EGS5コードを用い、モン テカルロシミュレーション計算^[1]を行った。その計算結 果を図29に示す。



図29 1次元照射単色X線のモンテカルロシミュレ ーションによる40keVX線の水中散乱分布

水槽表面からの深さ方向を z として深さが z = 0 cm、z=5cm、z=10cmの於ける断面散乱分布を求める と、図30のような断面分布が得られた。



図 30 単色X線1次元照射の断面に おける散乱分布

また、水槽表面(z=0cm)と深さ z=10cmの断面 における強度分布を指数関数で示すと図31の如くな った。 図29では、水槽の広い範囲に多数のX線散乱の 痕跡が見られるが、しかし、モンテカルロシミュレーシ ョン計算結果は、図31に示すように、線束の中心軌 跡から少し離れた場所のX線強度は急激に減少する ことが明らかである。この散乱は中心軸に対して希釈 であることを意味するが、水槽の30cmの深さjでも線 束は維持していることが明らかである。





次に、単色X線の1次元照射を図32に示すような3 次元的な照射に変換し、水槽中の吸収線量がどのよ うに変化するかを計算した。即ち、図29の1次元X線 照射(串差し)に於ける40keV単色X線束(10⁵本)を、 水槽表面で直径2cmの円内にX線束を均等に分散さ せ、水槽表面から深さ100mmで直径50µmの断面 に集束させるシステムを仮定し、X線輸送途上の散乱 分布と強度分布をEGS5の計算コードを用いてモン テカルロシミュレーションを行った。その計算結果を図 32に示す。これは、前に記述した如く、生体の表面に 相当する面に単色X線を1個放射できるX線源を10⁵ に並べて、X線源から同時にがん組織に向けて照射 できる理想的なX線定位照射のモデル計算に相当す る。

水中の40keV単色X線3次元照射における散乱分 布と線量空間分布の計算結果を図33に示す。同様 に水中に於ける40keV単色X線3次元照射の単位体 積当たりのX線エネルギー損失量分布のモンテカル ロシミュレーション計算結果を図34に示す。計算結果 から明らかなように、水中における線量損失分布 は、集束点で極大値をもつ曲線を描いた。この曲線 は陽子線や炭素線を生体組織に一次元照射したとき のエネルギー損失分布特性(ブラックピーク)に類似 している。



図32 1次元照射を3次元照射に変換

水槽表面から集束点まで単位体積当たりのエネル ギー損失分布は、図26に示した計算結果とほぼ等し く、水槽表面から集束点近傍までと集束点に於ける単 位体積当たりエネルギー損失比は非常に大きい。



図33 水中における3次元照射(40keV単色X 線)のX線強度と散乱分布

この計算結果は、40keVの単色X線の3次元照射

による放射線治療が、陽子線や炭素線を用いた放射 線治療で治療効果を高める特性のブラックピークに 遜色ないことを示唆していた。



Reference

[1] KEKの波戸、岩瀬の両氏と情報交換

9. 各種放射線の線量損失評価

運動エネルギーと質量の大きい荷電粒子は、水な どの軽元素中を通過するとき、最初は運動エネルギ ーが大きいので、物質との相互作用の確率や散乱も 小さく、また、物質との電離損失もほぼ一定である。し かし、通過距離が長くなると電離損失などで運動エネ ルギーを失い、粒子の速度が低減すると、物質との電 離損失エネルギーが急激に増大する。これが、陽子 線や炭素線に特徴的なブラックピークである。そこで、 PHITSとEGS5の計算コートを使って、深さ100mm の水中でエネルギー損失が最大になるように炭素線 と陽子線の入射エネルギーを調整したエネルギー損 失分布と3次元照射40keV単色X線のエネルギー損 失分布をモンテカルロシミュレーション計算の結果^[1] を図35に示す。

炭素線及び陽子線の一次元的照射と40keV単色 X線3次元照射のエネルギー損失量を比較規格化し た単位体積当たりのエネルギー損失分布の計算結果 を図36に示す。単位体積当たりの規格化エネルギー 損失は、220MeVの炭素粒子1個に対して、117Me Vの陽子粒子は20個、40keV単色X線は5個に相当 している。このことから、40keV単色X線の3次元照射は、生体表面から患部近くまで正常細胞に与える放射線損失が非常に少ないことがわかる。



図35 水中における炭素線、陽子線の1次元照射 と40keV単色X線3次元照射の単位体積当たりの 線量損失分布



図36 水中における炭素線、陽子線の1 次元照射 と40keV単色X線3次元照射の単位体積当たりの 規格化線量損失分布

Reference [1] KEKの波戸、岩瀬の両氏と情報交換

10. がんの放射線治療・診断には何が重要 か?

生体組織は多数の細胞で構築され、これらの細胞 は、軽元素である水素、炭素、窒素、酸素にリンや硫 黄の元素が加わるアミノ酸を単位に有機物質が構成 され、生活環境に適合する確保しながら自己や自然 淘汰を重ね、補完的な役割分担を身につけ、これら の進化の過程を記憶に留め、合理的な再生システム を構築することに依って獲得されたものであり、これら の機能再生のシステムは生体細胞内のDNAなどに 蓄積されている。生命体では色々な機能を発揮し処 理できる能力を持つ幹細胞を基軸に生命力を維持し ている。従って、がん化した幹細胞は、生命体の発 生時期から歴史的に経験した色々な事象に対処する 卓越した能力を持っている可能性が高い。がん化した 幹細胞によって増殖したがん細胞より、放射線や抗ガ ン剤などに対する耐性が遙かに強い。これががん再 発の一因を為すとも云われている。

また、生体に対する放射線の殺傷効果^[4]は、図29 に示すように、放射線被爆線量が2倍になると、生体 細胞の生存率は約2乗、被爆線量が3倍になると生存 率は3乗に逆比例して減少する。我々の関心の1つは、 単色X線照射の被爆線量の殺傷効果が、白色X線と どのような相違を示すかにある。



図29 各種放射線の生体に対する殺傷効果

がんに対する放射線治療の課題は、正常細胞とが ん細胞の被爆線量の比を如何に大きくするかにあり、 特に、がん化した幹細胞には、この比が大きい程、効 果的である。

一方、白色X線では、正常細胞が一次元的な串刺 し特性による放射線損失弊害を避けるために、図30 に示すように、がんなどの腫瘍を中心に小型の電子リ ニアックを回転させ、周囲からX線を2次元的に照射 する方法(X線定位照射)が開発され、これが究極の 放射線治療方法として採用されるようになった。



図30 白色X線の2次元定位照射

ここで、定位照射の方法では、どんな放射線照射 が理想的であるかを考察する。既に述べたように、放 射線治療では正常細胞とがん腫瘍の被爆線量の比 を出来るだけ大きくすることが重要であり、被爆線量 の比を最大にする方法は、図31に示すように、最適 なエネルギーの放射線1個を球面のあらゆる場所から、 同時に、がん腫瘍がある球の中心に向けて照射する ことである。これは、図32に示す γ ナイフや色々な方 向からX線を照射できるサイバーナイフが、この照射 方法に近い。

しかし、放射線エネルギーの選択、照射点の多さ、 同時照射などに大きな違いがある。放射線のエネル ギーは、球の物質による吸収係数(或いは反応断面 積)と球の表面から球の中心までの距離に依存する ので、正常細胞の被爆線量が最小(低LET)になるよ うに放射線エネルギーを選択することが重要となる。

しかしながら、現実的な放射線治療に於いて、 図31の構図を実現することは、幾何学的に不可能で ある。そこで、理想的な放射線治療を部分的に実現 できる具体案として、図23に示したように、可干渉性 単色X線をフレーネル レンズなどで集束し、がん組 織を3次元的にピンポイントで放射線照射することを 考えた。この方法は、時空間を合わせると4次元照射 であり、がん組織と正常組織の被爆線量比を大きくす る状態が実現できる。3次元単色X線治療の特徴は、 分散した多数の単色X線を同時にがん腫瘍に集中し て照射でき、且つ被爆線量が少ないことにある。



図31 がん治療の理想的な放射線定位照射の概念図



図32 γ ナイフ、ソース:⁶⁰Co、半減期:5.3年、 β⁻:2.8MeV、スリット数:200~2000

これが実現可能なのは、可干渉性X線源が、準単 色で位相が揃った優れた特性を持つX線であることに 因る。この特性を活かして、X線を集束しピンポイント でがん組織を照射すると、がん患部は大きな放射線 損傷を受け、強力な抵抗力を備えたがん化した幹細 胞の殺傷も可能となり、がんの再発も抑制できる。

一方、単色硬X線の集束は、ドイツのカールスルウ ェ大学のM.Simonらがポリイミトフィルムのロールを 用いた大口径X線レンズ^[5]の集束に成功している。こ れらのがん治療装置は小型で建設費も安価であり、ラ ンニングコストを小さいので、多くのがん患者を救うこ とができる。

例えば、生体表面から約100mmの深さにがん腫瘍が あり、がん腫瘍に40keVの単色X線束(2×10⁹個/ mm³:2Gy)を定位照射には、がん細胞に到達するま でに約92%のX線が途中で吸収される。従って、約2 ×10¹⁰個の単色X線を発生するX線源が必要となる。 2次元定位照射のように1台のX線源で場所と方向を 変えて照射するには、2×10¹⁰回繰り返すことになる。 照射場所と方向の設定に1秒の時間が必要とすると、 照射が終了まで、634年の歳月を必要することになり、 この方法は意味を成さない。しかし、図23に示すよう な3次元的放射線照射では、照射作業が約1秒間で 終了する。例えば、位相の揃った単色X線で生体軟 組織を照射し、図12や図14に示したように、X線カメ ラなどのX線計測器を被写体から移動させて撮像(伝 搬法)するか或いは被写体の後方に設置された単結 晶を回転し位相差を強調した画像を撮像するならば、 軟組織構造のイメージをX線強度の濃淡として撮像で きる。即ち、生体軟組織などの内部構造は被写体の 距離の関数や単結晶の回転角度関数として撮像でき る。これらの位相コントラスト映像はデーター処理によ って立体構造に構築することが可能である。

一方、軟組織における位相コントラストは、吸収コン トラストより感度が約1000倍高い。位相の揃った単色 X線を生体の軟組織に照射すると、X線は軟組織構 造によって屈折し、被写体からの距離に依存してX線 密度が変わる。(このメカニズムの詳細は図26、図27 を参照のこと)。この特性を活用すると、少ない被爆線 量でX線CTに相当する医療診断が可能になる。準単 色で位相が揃った可干渉性X線は、更に用途が広が る。例えば、X線集束によるがん組織の3次元的照射、 或いは、生体軟組織の構造画像の位相コントラスト撮 像など、全く新しいがん治療・診断を創生するもので ある。 これら特性を活用すると、陽子線や炭素線のブラッ クピーク特性による放射線治療、或いは、造影剤負荷 のX線CT診断を凌駕する可能性がある。

しかし、可干渉性単色X線源によるがん治療・診断 装置を普及させるには、装置自体が小型で且つ建設 費と治療費が安価であることが必須の条件である。

特に、X線発生装置の小型化には、コンパクト加速 器の開発が必須の条件であり、特に電子リニアックで

11.コンパクト可干渉性単色X線源の開発

大多数の病院では小型電子リニアックを基軸とする放 射線治療を実施しているが、これらの装置と同様に医 療現場に普及するには、可干渉性単色X線源が小型 であり、限られた面積や空間に設置できることが必須 の条件である。一方、可干渉性単色X線を発生させる には、高品質で大強度の100MeV級電子ビームが必 要条件であるが、しかし、薄い単結晶に電子ビームを 照射して、電子ビームの僅かなエネルギーがX線に変 換されるだけである。従って、照射後に電子ビームをタ ンパーに棄てて大量の y線や中性子線などの発生こ とを防ぐには、残留エネルギーを高周波電力として回 収して、2次的な放射線の発生を軽減すると共に、回 収した高周波電力を再び加速エネルギーとして利用 する図33に示すようなエネルギー回収システムが不 可欠となる。



図33 エネルギー回収型電子線形加速器の概念図

当初は、エネルギー回収システムに超伝導電子リニ アックを予定していた。しかし、超伝導加速空洞は高 電界にすると電界放出電子が大量に発生し、超伝導 は大きな加速電界強度を得ることが重要となる。

その目的達成のため、高純度銅を極低温に冷却す ると電気抵抗が小さくなる特性を活用し、且つ異常表 皮効果を考慮した高周波損失の少ないクライオ電子リ ニアックを基軸に調査研究を進めた。その結果、50 MeV/mの高電界加速と加速電子ビームから高周波 電力としてエネルギーを回収できる可能性があること が分った。

状態が壊れることが予測され、25MeV/mが実用的な 限界であり、100MeV級の加速システムの長さは5m を超える。これは加速装置のコンパクト化を制約する。

そこで、超伝導電子リニアックと同等にエネルギーが 回復するコンパクト加速システムを探究するため、「大 強度コンパクト空間干渉X線源の開発を目標に新たな 検討」を開始した。最初は、電子銃とバンチャーからな る入射部で数MeVに加速した電子ビームを定在波型 加速管で数十MeVに加速して、この電子ビームを18 0度偏向しWork Areaで薄い単結晶を照射後、更に1 80度偏向し、再び加速管の減速位相に入射して、電 子ビームからエネルギーを高周波電力として回収する システムを想定し、実用的なエネルギー回収システム が成り立つかどうかを検討した。

先ず、加減速管にSバンドの常伝導の定在波型加 速管を想定し、電子ビームを加速後に減速電子ビー ムから高周波電力を回収し加速高周波電力として再 利用することを試みた。その計算結果では、電子ビー ムの加減速は達成されるが、加速管で消費される高周 波電力が大きいために、減速によって回収した高周波 電力では、後続の電子ビーム加速に必要な高周波電 力を賄えないために、高周波源から大電力を供給する ことになり、従って、ビーム負荷率も大きく制限される。 また、この方法の最大の問題点は、単結晶を照射した 際に受ける加速ビームのエミッタンス増大が、減速ビ ームからそのまま加速管に持ち込まれるために、加速 ビームのエミッタンスも悪化することにある。そこで、こ

の弊害を避けるために、単結晶の照射によって悪化す る電子ビームのエミッタンスのブローアップ成分を加速 システムに持ち込まないようにするために、図34に示 すように、加速管と減速管を直列に並べて、それぞれ 加減速管の入出力空洞を導波管で接続し、加速管と 減速管を分離して高周波の閉回路を形成する。



システムの概念図

この閉回路では、ビームのブローアップ成分は減速管 で放射され蓄積・減衰し、加速管には移動しないよう に処置することができる。この閉回路では、高周波電 力が加速管と減速管を進行波として通過し還流する。

従って、高周波電力損失は、加減速管の長さが同 じであるならば、定在波加速管1本に等しい。また、加 速管と減速管で閉回路を形成する還流型加減速シス テムでは、加速と減速の2つの機能を完全に分離でき るので、電子ビームの加減速特性と加源速管の高周 波電力損失を明白にできるのが特長である。

このモデルを使って、加速管の高周波電力損失が どの程度であれば、電子リニアックのエネルギー回収 システムが成り立つがを調査した。

構想

最初に、通常の銅材で製作されたSバンド(2856M Hz)の加速管の加減速特性を、図34に示すようなモ デルを使って検討した。即ち、閉回路に高周波電力を

供給し定常状態になった時点で入射部から電子ビー ムを入射し、加速システムの加減速特性と高周波電力 損失を計算した。

その結果、常温では、加速特性は適合するが、予 想通りに加減速管を還流する高周波電力損失が大き いため、減速管から満足する高周波電力量が得られ ず、エネルギー回収システムは機能しなかった。エネ ルギー回収は超伝導空洞以外に方法はないのかを改 めて調査した。

最近、超伝導材の補材として開発された高純度銅 は、低温に冷却すると電気抵抗が残留抵抗まで低減 する図35に示すような特性を持つことが分かった。





ここで、RRR-100は、銅を低温に冷却した時、残 留抵抗が常温の比抵抗の1/100であることを意味す 12. エネルギー回収型クライオ電子リニアックの る。そこで、高純度銅を低温にすると電気抵抗が低減 する特性を活用すると、電子リニアックに於いてエネル ギー回収が可能かどうかを検討した。無酸素銅(RRR -30相当)で製作した加速管を液体窒素温度まで冷 却すると、モデル閉回路のエネルギー回収がとうなる

かを計算した。但し、加速管の高周波電力損失は高 周波空洞の表面電気抵抗に依存し、表皮の深さの関 数とした。即ち、表皮の深さ δ は比抵抗 ρ 、周波数f、 透磁率 μ の関数($\delta = (2\rho / \omega \mu)$ に依存すると仮定 した。計算結果は、常温の場合より、エネルギー回収 特性は、或る程度改善されたが、実用化には不十分 であった。

次に、RRR-1000, RRR-3000、RRR-6000な どの色々な銅材の加速管で閉回路を構成し、液体水 素温度に冷却した場合、閉回路の加減速特性がどの ように変化するかを検討した。最終的には、加速管を RRR-6000で製作し、加速電界強度を高めるため、 加速周波数をSバンド(2856MHz)からCバンド(571 6MHz)に変え、加速空洞構造の最適化を選択し、2 0Kに冷却した場合の加速特性を求めた。計算結果で は、エネルギー回収が可能で卓上型クライオ電子リニ アックが実現可能であることを示唆した。しかし、マイク 口波領域では、異常表皮効果による加速性能低下が 予測され、RRR-6000でテスト空洞を製作し、テスト 空洞の高周波損失の温度依存性を測定することになったが、テスト空洞のQ_L値は、拡散接合によって、約1 った。

Reference

[1] 低温工学協会編、「超伝導・低温工学ハンドブック」、 オーム社(1993年)

13. テスト空洞の低温特性

テスト空洞は、図36に示すように、Cバンド2π/3 モードの3空洞構造で設計され、RRR-6000相当の 7N銅材を用い拡散接合方法^[1]で作成された。

テスト空洞は拡散接合後、排気し大気漏れテストを 実施したが、漏れは感知されなかった。また、テスト空 洞には、図37に示すように入出力端子が取り付けられ、 拡散接合の前後に常温、大気圧の環境で、高周波損 失の測定が、ネットワークアナライザーを用いて行った。 測定結果は、拡散接合前のテスト空洞の共振周波数 が、f=5.71810GHz、テスト空洞の負荷利益係数が、 $Q_{L} = 6148$ であった。

Cバンド2π/3モードテスト円筒空洞



図36 Cバンド2π/3モードテスト空洞の断面図

また、拡散接合後の共振周波数が、f=5.718189 GHz, $Q_I = 6913$ $\sigma b_0 c_{\delta_0}$

拡散接合前後で共振周波数の変化は89kHzと小さか



図37 拡散接合で製作したCバンド2π/3モード テスト空洞

2%改善された。これは、高周波空洞を構成する部品 の接触面が拡散接合により一体化し、接触抵抗が低 減したためと考えられる。

高純度銅材の拡散接合は、高周波空洞の性能向 上に有効であり、且つ真空容器として使用できることを



図38 テスト空洞の高周波損失係数Q_Lの 温度依存性

確認した。

次にテスト空洞は、クライオスタットに収納し、入出力 ケーブルの結合度を常温で計測した後、極低温:10 Kに冷却した。テスト空洞の高周波損失係数: Q_L は、1 OKに冷却した後に、10Kから300Kの温度領域でネ ットワークアナライザーを用いて連続的に測定^[2]された。 入出力端の結合度は、テスト空洞を10Kに冷却すると、 常温の約3倍になったが、この変化でテスト空洞の無 負荷利益係数Q。値は、オーダーで変わることは予測 されなかった。テスト空洞のQ_Lの温度依存性は、図38 に示すように、10~20Kの温度範囲では、ほぼ一定 で、その平均はQ_L=33618であった。また、20K~3 O0Kの温度範囲では、Q_L値が大きく低減した。常温 (300K)の平均QL値は、Q_L=6174であった。

参考のため、テスト空洞の共振周波数fの温度依存 性の測定結果を、図49に示す。10Kから40Kの低温 領域では共振周波数の温度変化は小さいが、40Kより 高温領域では、急激に増大する。この変化は、銅の線 膨張の温度係数に相当している。





一方、テスト空洞の Q_L の温度依存性は、表皮の 深さ δ に基づく計算結果と異なる値を示した。

これは、明らかに異常表皮効果の影響による結 果と考え、エネルギー回収型の高周波還流加速シ ステムの高周波損失をテスト空洞の実測値を使っ て再計算することになった。

参考資料として、テスト空洞設計寸法を表2に、銅 材の温度依存性と高周波特性に関する設計パラメー ターを表3、テスト空洞の拡散接合前後の高周波特性 の変化、並びに温度依存性の測定結果を表4に示 す。

表2 テスト空洞設計寸法

共振周波数	5712 MHz
デスク穴径(2a)	13.500 mm
デスク穴エッジの曲率半径(ρ)	1.298 mm
デスク板の厚さ(t)	2.500 mm
円筒空洞内直径(2b)	41.700 mm
円筒空洞長(D)	15.000 mm

表3 テスト空洞の高周波特性の設計パラメーター

温度	比抵抗	表皮深さδ	Q ₀ 値	R_0	材料
K°	Ω/m	10^{-8} m	10^{3}	$M\Omega/m$	RRR
300	1.72×10^{-1}	⁸ 87.4	8.6	93	30
20	2×10^{-1}	1 2.97	253	2757	1000
20	9.5×10^{-12}	2^{2} 2.5	367	3982	6000

表4 テスト空洞の計測高周波特性

温度	比抵抗	拡散接合	合 周波数	Q_L 値	材料
K°	Ω/m		$10^9 \mathrm{Hz}$	10^{3}	RRR
300	1.72×10^{-1}	⁻⁸ 前	5.7181	6.148	6000
300	1.72×10^{-1}	⁻⁸ 後	5.7182	6.913	6000
20	9.5×10^{-5}	⁻¹² 後	5.7389	33.858	6000
300	9.5×10^{-1}	⁻¹² 後	5.7181	5.977	6000

高純度銅材 (7N:RRR-6000)の直流抵抗を基準 とする比抵抗 ρ は、表3に示すように、常温で ρ =1.7 2×10⁻⁸ Ω /m、20Kで ρ =9.5×10⁻¹² Ω /mであ る。

もし、異常表皮効果がないと仮定し、20Kに冷却し たテスト空洞の無負荷利益係数: Q_0 は、表皮の深さ δ で計算すると、 Q_0 =367000となる。しかし、テスト空 洞の負荷利益係数 Q_L の実測値は、表4に示すように、 Q_L =33858であった。計算値の Q_0 と実測値の Q_L の 大きな差は、異常表皮効果によるものと推定される。 ネットワークアナライザーを用いて、テスト空洞の Q_0 の 温度依存性を相対的に計測することは容易であるが、 Q_0 の絶対値の測定には、不確定要素が加わり容易で はない。20Kと常温で計測されたテスト空洞の Q_L は、 同じ測定器で計測した値であり、その比には不確定要 素が小さいので、 Q_L を基準に表皮効果の評価を行うこ とにした。

Reference

[1] KEKの高畠氏との情報交換

[2] KEKの吉田氏との情報交換.

14. 異常表皮効果の評価

一般論として、テスト空洞の利益係数Qは、その高

周波損失と密接に関連し、テスト空洞に蓄えられる電磁エネルギーUとテスト空洞で1サイクルの間で消費される平均電力損失(P/ω)の比で定義され、

空洞に蓄えられる電磁エネルギーUは、空洞内に 励起される磁界Hの2乗の体積積分で表され、

 $U = \int_{V} H_{V}^{2} dv$ (21)

で与えられる。また、空洞の電力損失Pは、空洞壁 の電気抵抗をRSとすると、

$$P=R_s/2\int_s H_s^2 ds$$
 (23)
で記述され、また、空洞の表皮の深さを δ とすると

 $P=(\delta/2)\{\int sH_a^2da\}$ で記述される。

従って、

$$Q = (2/\delta) \{ \int_{v} H_{v}^{2} dv \} / \{ \int s H_{a}^{2} da \}$$

= (2/\delta) K
= (2/R_{s}) \{ \int_{v} H_{v}^{2} dv \} / \{ \int s H_{a}^{2} da \}

$$(2/R_{\rm S}) \,\mathrm{K} \tag{24}$$

で表される。ここで、K={ $\int_{v}H_{v}^{2}dv$ }/{ $\int_{s}H_{s}^{2}da$ }で、 Kはテスト空洞の構造のみ依存する関数で定数である。 Kの値は、デスク負荷構造加速管の計算式^[16]から得られ、テスト空洞のKの計算値は、K=3.782(Ω mm) であった。

異常表皮効果が予想される20Kの低温では、電子リ ニアックの設計に、RRRで表示した比抵抗値をそのま ま加速管の設計には使えない。

そこで、(24)のRs=K/Q₀から高周波抵抗R_sを計 算し、それと対価の比抵抗を求めた。

異常表皮効果を考慮した比抵抗を ρ *で記述する と、 $\delta = (2 \rho^* / \omega \mu)^{1/2} i R_s$ と等価であり、

 $\rho^* = R_s^2 \omega \mu / 2$ (25)
と記述できる。 20Kのテスト空洞のQ₀値の代わりに、
実測値のQ_Lを用いて、R_sを計算すると、R_s=1.117
×10⁻⁴(Ωmm)となる。一方、(2)から ρ^* は、 $\rho^* = 2.826 \times 10^{-10} (\Omega/m)$ である。

銅の比抵抗 ρ は常温で $\rho = 1.72 \times 10^{-8} (\Omega/m)$ であり、これをRRR-1の記述符号を基準にすると、異

常表皮効果を考慮した20Kに於けるRRR-6000の するが、そのエネルギー損失は、高々数keV~数百k 比抵抗は、ρ/ρ*=60.8と等価と見なすことが出来る。eVに過ぎない。従って、電子ビームのビーム電流が多 即ち、20Kで稼働するテスト空洞では、測定値QLを基い場合、この電子ビームをビームダンプに直接投射す 準にすると、RRR-6000はRRR-61と等価である。

は、表4から、R=33858/5977=5.66となる。これは、要し、放射線発生装置は大型になる。 RRR-6000の高純度銅を20Kに冷却した時、

 $\rho / \rho^* = R \times 2 = 64$ であることからも、妥当であると言 波電力として回収し、 γ 線や中性子などの2次放射線 える。

高純度銅に応力歪みがなく、Q_LとQ₀の測定に大き な誤差がない場合、C バンドテスト加速空洞の測定結 果から、異常表皮効果を考慮した5.739GHzに於け る高周波抵抗成分は、直流抵抗に換算してRRR-6 1以上であると推定される。ここでは、テスト空洞のQ」と Q₀の比が0.9、RRR-6000がRRR-66と等価であ ると仮定して、クライオ電子リニアックのCバンド加速管 の再設計を行った。

15.100MeV級テーブルトップ電子リニアック

繰り返し述べてきたように、がんの放射線治療効果 を高めるには、がん腫瘍と正常細胞の被爆線量比を 大きくすることが重要であり、そのためには、放射線を 集束してがん腫瘍に向けて、3次元的に同時照射を行 う必要がある。この状態をX線で実現するには、単色 で干渉性を持ち透過力あるコンパクトなX線の発生源 が必要となる。可干渉性単色X線は、100MeV級の 電子ビームを数~数百ミクロンの薄い単結晶に照射し て得られるが、これには高品質の高エネルギー電子ビ ームが必要である。可干渉性単色X線は、電子ビーム が単結晶の原子間の通り抜けるとき、ローレンツ圧縮さ れた電子の電場が単結晶の原子を強い近接場効果 で摂動し、原子の電子群を分極振動させ、その波動が 単結晶の周期構造場を伝搬し、単結晶格子面でブラ ック反射して、結晶面からパラメトリックX線放射として 発生する。

薄い単結晶を通過中に、電子ビームは周期構造場 にウェーク場、制動輻射、電離エネルギーなどを放出

ると、γ線や中性子などの2次放射線を大量に発生し、 一方、テスト空洞の20Kと常温で計測されたQ₁の比 それらを遮蔽するために、膨大な放射線シールドを必

> これを避けるには、電子ビームのエネルギーを高周 の発生を可能な限り制限することが不可欠となる。

> そこで、テスト空洞実験データー(図38のQLデータ ー)を基軸に、異常表皮効果を考慮した閉回路に於い て、クライオ電子リニアックがエネルギー回収を可能で あるかどうかを評価するため、閉回路をユニットにした 加減速特性の再計算を行った。

> 長さ約50cmのCバンド加速管2本を1対とする加減 速ができる閉回路システムを20Kに冷却し、閉回路に 22.5MWの高周波電力を環流させ、0.2Aの電子ビ ームを供給すると、図41に示すように、電子ビームを 約25MeVに加速できる。この電子ビームで単結晶を 照射し、約50cmの減速管に輸送して電子ビームを減 速すると、約19.5MWの高周波電力を回収でき、これ を加速管に還流し再利用ができる。



図40 Cバンドクライオ電子リニアックの 加減速特性

図34に示すような閉回路では、加速管入力空洞に 供給される高周波電力と減速管終端の出力空洞から 流出する高周波電力の差が加減速管で消費された高 周波電力を意味する。また、閉回路の定常状態では、

この差の高周波電力を高周波源(クライストロン)から 短い加速管と減速管を1セットにした閉回路に小電力 方向性結合器を通して供給する。従って、パルスの積 み上げには、高周波電力が閉回路を短い時間で周回 することが重要となる。短い時間で積み上げるには、ク ライストロン出力電力の変調比が大きくなる。この加速 システムでは、高周波電力損失の少ない短い加速管 と減速管を1セットにした閉回路に小電力高周波電力 を積み上げ、大電力が還流する状態にしてから、電子 ビームを加速管に入射することになる。

この加速システムでは、高周波電力損失の少ない



図41 Cバンドクライオ電子リニアックの常温に 於ける加減速特性

高周波電力を積み上げ、大電力が還流する状態にし てから、電子ビームを加速管に入射することになる。 電子ビームが加速管に入射すると、高周波電力が電 子ビームエネルギーに変換され加速管終端で電子ビ ームのエネルギーは最大になり高周波電力は最小に なる(図40の左半分を参照)。

電子ビームが減速管に移行すると、電子ビームエネ ルギーが減速管に高周波電力として変換されて、減 少した高周波電力は減速管終端で最大となり、エネル ギー回収の機能が果たされる(図40の右半分を参 照)。

以上の検討から、この閉回路を4セット並列に構成し、 各閉回路に22.5MWの高周波電力を環流させると、 0.2Aの電子ビームを100MeV以上に加速でき、加 速後に入射エネルギーまで減速できることが判明した。 参考のために、Cbandクライオ電子リニアックの加減 速特性を常温に戻した場合、加減速特性がどうのよう に変化するかを、図41に示す。

このことから、100MeV級の電子リニアックをテーブ ルトップにすることは夢でない。実用性に耐えるものが 実現するならば、放射線治療分野に新たなメデカル・



図42 クライオ・電子リニアックの構成ブロック図



図43 クライオ・電子リニアックの配置ブロック図



図44 テープトップ電子リニアックのクライオ スタットの断面図

イノベーションを創成することができ、21世紀の長寿 化社会における医療福祉やX線科学の進展に新たな 展開が開けると期待できる。単結晶を通り抜けた電子 ビームのエネルギーを再び高周波電力に変換して、 放射線遮蔽を軽減し、高周波電力を電子リニアックの 加速に再利用する。エネルギー回収型電子リニアック の必要性は以上の理由に依る。閉回路を4段に並べ た最もシンプルなテーブルトップ電子リニアックをベー スに、コンパクトなコヒーレント単色X線源のモデルを 基盤とする具体的なブロック回路を図42に示す。また、 X線発生装置を含むクライオ電子リニアックの基本配 置図の凡例を図43に示す。また、加速管4本で構成さ れる加減速システムを 1 個のクライオスタットに収容した具体例を図44に示す。

冷却装置と高周波パルス電源を除いた加速器とX 線発生装置の主要な装置は含まれており、電子リニア ック本体は2.3×1.5m²の面積に収まり、テーブルトッ プ型コレーレントX線源が実現する可能性を示唆して いる。カンターバランスを良くするとタンテーブルに搭

載することも可能になり、医療診断や放射線治療用 のX線源として高度な機能が発揮できる。

特に、X線発生用の単結晶にダイヤモンド単結晶を用 いると、X線エネルギーはシリコンの2倍弱であり、厚さ が1μmの場合、100MeVの照射電子ビームが制動 輻射で失うエネルギーは2keV程度である。

従って、照射用単結晶から放射される y 線や中性子 の線量は非常に少ないため治療室に直接X線発生装 置を持ち込める可能性が高く、使い勝手は非常によく なる。

現在の銅の素材はRRR-3000であるが、RRR-10 000が流通するようになれば、電子リニアックの熱負荷 が42%削減され、冷凍設備のコストも低減できる。 S バンド電子リニアックとCバンド電子リニアックの比較で は、Cバンド電子リニアックは長さがSバンド電子リニア ックの約1/2、容積は約1/8であり、容積はコスト低減 の大きな要因となり得る。これがCバンド加速管を選択 する理由の1つである。表5には、40keVの単色X線 が10¹²/秒個得られる、X線発生装置を目標に設計 したテーブルトップ型クライオ電子リニアックのパラメー ターの凡例を示す。

表5 テーブルトップ型クライオ電子リニアックのパラメ

<u>-9-</u>	
クライオ加速システム	エネルギー回復方式
冷却温度	−253° C
冷却保全	クライオスタット
加速管素材	RRR-6000
電子銃	熱陰極3極管
電子銃電圧	-150kV
最大ビーム電流	1.5A
規格化エミッタンス	$< 5 \pi\mathrm{mm}\cdot\mathrm{mrad}$
プレバンチャー(空洞数)	3
バンチャー(空洞数)	12
入射ビームエネルギー	2.5 MeV
マクロパルスビーム電流	0.2~1.0A
加速周波数	5.712 GHz
加速モード	$2\pi/3$
加速方式	進行波環流
加速管構造	デスク負荷進行波型
加減速管空洞数	29~30
加速管の全長	$1014 \times 4 \text{ mm}$
環流周回時間	500ns
加速エネルギー	$101{\sim}74.4 \mathrm{MeV}$
高周波電力	22.5×4 MW
積算電界減衰量(αL)	0.135
高周波尖頭電力損失	1.1×4 MW
ジュール損失(平均)	$\sim 880 \mathrm{W}$
高周波電力負荷率	$2 imes 10^{-4}$
平均ビーム電力	$2.9 \sim 20.2 \text{kW}$
平均ビーム電流	$40\sim\!200\mu\mathrm{A}$
X線の全線束数	$\sim \! 10^{11} / \mathrm{S}$
パルス持続時間	10 μs

繰り替え数	10 pps
高周波源	クライストロン×1本
クライストロン(グリット変調)	出力変調型
尖頭高周波出力電力	$3\sim 30 \mathrm{MW}$
平均高周波出力電力	$12 \mathrm{kW}$
パルス電源	30kW

16. おわりに

高齢化が進む日本では、ガン患者が急増し、ガン は死因の主な要因であり、ガン対策は大きな社会問題 である。特に、若い年代のガン患者は進行が早く、ガ ン腫瘍を早急に除去し、完治できる方策を確立しなけ ればならない。最近、X線、y線、中性子線、陽子線、 炭素線などによる定位照射を中心に放射線治療が盛 んに行われている。

γナイフ、サイバーナイフ、或いはブラックピーク特 性を活用した粒子線など高尚な定位照射にはそれぞ れ特長があり、優劣を比較することは難しいが、ここで、 理想的な定位照射とは何かを、もう一度詳細に検討す る時期に来ていると思われる。

可干渉性単色X線源によるガン治療・診断の接点 は始まったばかりであり、放射線、医学物理、生命科 学、加速器などに係わる多くの研究者や技術者の力 を結集し、これから派生する諸問題と真摯に対峙する ことが重要であり、関連機関による真摯な対応に期待 を寄せている。

この概念設計は数年前に基盤研究Sに応募した研 究課題「コンパクト空間干渉X線源の開発」を基軸に 草案したものである。本プロジェクトを推進するために、 色々な計画と連携する機会が多くなり、平成22年4月、 JSTの機器開発プログラムに応募し、7月にヒヤリング を受けたが、機が熟していないためか、採択には到ら なかった。本プロジェクトは、その時の応募内容を基軸 に纏めたものである。

クライオ電子リニアックは、これまでの加速器の常識 に対する新たな挑戦でもあり、加速管の素材、環境、 構造を融合させ複合的に検討しない限り、決して成し 得ない代物である。一方、「電子リニアックに於けるエ ネルギー回復が超伝導空洞を用いる以外に可能性は 無いのか?」の視点に立ち、常温における電子リニア ックの近接場の緩い構造(デスク穴径の大きい)の検 討から液体水素温度の金属素材の特性まで視野を広 げた検討を行った。これまでの電子リニアック優れた特 性(電子のウェーク場と相互作用の大きい:R/Qが大 きい)を活かし、且つ普通の金属電気抵抗が極限まで 小さくなる素材と温度環境を活用すると加速空洞の電 気抵抗が常温の数百分の1~数千分の1になり、閉回 路のエネルギー回収はほぼ達成され、残留エネルギ ーも1MeV以下にできることを見出した。

一方、RRR-6000相当の純銅で制作したテスト空 洞の高周波損失特性はQ_Lの温度依存性に明確現れ、 クライオ電子リニアックの実現の可能性を示唆している。 PXRに於けるコヒーレントX線の発生は、単結晶に入 射する個々の電子のウェーク場と単結晶の周期構造 結晶場の相互作用によるものであり、原子配列された 周期構造はÅオーダーであり、この近接場効果の強 い距離を電子が通り抜けることがPXRの輝度を高めて いる要因である。X線強度を最強にするには、単結晶 の周期数の最適化は非常に重要な研究課題であると 考えている。

コンパク電子リニアックの検討には、高周波空洞特 性の色々なパラメーターが必要とする。これらパラメー ターを追求するのに、高周波空洞を解析的に解くこと ができるDDCコード(中村プログラム^[1])は、非常に有 効であった。このコードを使って計算した結果では、超 伝導電子リニアックでなくとも、高純度銅材(7N相当) で加速管を製作し、20Kに冷却すれば、異常表皮効 果を考慮しても、エネルギー回復が可能であることを 示唆している。

Reference

[1] Masao NAKAMURA, "A Computational Method for Disk Loaded Waveguides with Rounded Disk- Hole Edges" JJAP,Vol.7,No.3, (1968) p257-271.